

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 832 995

②1 N° d'enregistrement national : **01 15647**

⑤1 Int Cl⁷ : B 82 B 3/00, B 32 B 15/00, C 01 B 31/02, 33/06, 35/14

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 04.12.01.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 06.06.03 Bulletin 03/23.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : *THALES Société anonyme — FR.*

⑦2 Inventeur(s) : LEGAGNEUX PIERRE, PRIBAT
DIDIER et NEDELLEC YANNIG.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : THALES "INTELLECTUAL PRO-
PERTY".

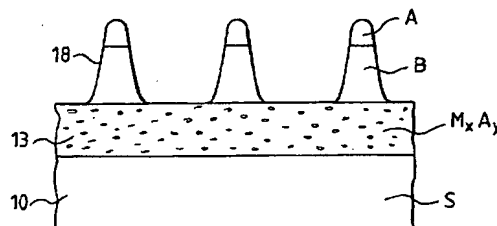
⑤4 PROCÉDE DE CROISSANCE CATALYTIQUE DE NANOTUBES OU NANOFIBRES COMPRENANT UNE
BARRIÈRE DE DIFFUSION DE TYPE ALLIAGE NISI.

⑤7 L'invention concerne un procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres sur un substrat comportant au moins une couche supérieure en un premier matériau, caractérisé en ce qu'il comprend :

- la formation à la surface de la couche supérieure, d'une couche barrière constituée d'un alliage du premier matériau et d'un second matériau, ledit alliage étant stable à une première température;
- la formation de plots de catalyseur constitués du second matériau, à la surface de la couche d'alliage;
- la croissance de nanotubes ou nanofibres à une seconde température inférieure à ladite première température.

La couche d'alliage, permet une croissance efficace des nanotubes/nanofibres à partir de plots de catalyseur à la surface de ladite couche d'alliage. En effet la couche d'alliage constitue une barrière de diffusion vis-à-vis du catalyseur sur le substrat de croissance, stable à la température de croissance catalytique des nanotubes/ nanofibres.

Applications : nanotechnologie, dispositifs à émission de champ.



FR 2 832 995 - A1



**PROCEDE DE CROISSANCE CATALYTIQUE DE NANOTUBES OU
NANOFIBRES COMPRENANT UNE BARRIERE DE DIFFUSION DE TYPE
ALLIAGE NiSi**

5

Le domaine de l'invention est celui des nanotubes ou nanofibres pouvant être de type carbone, silicium, bore ou de tout autre alliage basé sur l'un au moins de ces composants (par exemple SiC) et pouvant comprendre
10 de l'azote (SiN, BN, SiCN). Typiquement, ces nanotubes ou nanofibres présentent des diamètres de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres sur plusieurs microns de hauteur.

Ils sont particulièrement intéressants pour la nanotechnologie, les matériaux composites, les électrodes de batterie, le stockage de l'énergie, la
15 nanoélectronique, les dispositifs à émission de champ.

En ce qui concerne la nanotechnologie, les applications sont le design et l'engineering moléculaire, les nanopointes (pour la métrologie), les actuateurs, robots, capteurs et donc les MEMS (Micro electromechanical systems).

20 En ce qui concerne le stockage de l'énergie, les applications sont la pile à combustible qui utilise les propriétés de stockage de l'hydrogène des nanotubes et aussi les supercapacités.

La nanoélectronique inclue les composants électroniques classiques (diodes, transistors, capacités), l'électronique moléculaire et les
25 futurs composants pour les futurs ordinateurs (carbon nanotube molecular computer).

Dans le cas des dispositifs à émission de champ, les applications sont les sources froides d'électrons pour la microscopie électronique, les équipements d'analyse utilisant un faisceau électronique, la
30 nanolithographie, les tubes électroniques, les propulseurs ioniques et les dispositifs d'affichage plats.

La croissance de nanotubes/nanofibres sur un substrat ou un support est effectuée sur des agrégats de catalyseur de très faibles dimensions (< 100 nm) à une température généralement supérieure à 500°C
35 et pouvant dépasser les 1000°C.

De manière classique, la réalisation de nanotubes ou nanofibres est effectuée par croissance à partir de plots de catalyseurs de faibles dimensions qui peuvent être définis par lithographie. La Figure 1 illustre une telle croissance. A partir d'un substrat 1, on effectue des ouvertures submicroniques (de préférence de l'ordre de 100nm) dans une résine 2, (Figure 1a). Puis on dépose du catalyseur en couche mince 3, sur une épaisseur inférieure à environ 10nm (Figure 1b). Après une étape de dissolution de la résine (Figure 1c), on obtient des plots de catalyseurs de diamètre équivalent au diamètre des ouvertures de la résine. On procède alors à la croissance de nanotubes ou nanofibres (Figure 1c).

Les méthodes de préparation sont : la décharge électrique, la pyrolyse, les méthodes par voie physique telle que l'ablation laser et les méthodes par voie chimique CVD (chemical vapor deposition) ou PECVD (Plasma enhanced CVD).

La méthode qui semble la mieux adaptée pour l'application cathode à effet de champ est la méthode PECVD qui est assistée par plasma DC (plasma continu), RF (radio fréquence) ou microonde. En effet, elle permet l'obtention de nanotubes et nanofibres orientés perpendiculairement par rapport au substrat.

Les nanotubes ou nanofibres montrés sur toutes les figures de la demande sont dessinés de façon schématique. Les nanotubes contrairement aux nanofibres sont creux

Par exemple, dans le cas de nanotubes de carbone, le diamètre des nanotubes est proche de celui de la particule de catalyseur. Du fait de la forme allongée que prend cette particule (voir Figure 1d) en matériau B (pouvant être C, SiC, BN,), son diamètre est plus faible que celui des plots préalablement définis par lithographie.

Néanmoins, si lors de l'étape de mise en température du substrat ou support, les agrégats de catalyseur diffusent ou sont dissous dans le substrat ou support, il n'y aura pas alors de croissance de nanotubes/nanofibres. Il est donc primordial de déposer une barrière de diffusion efficace préalablement au dépôt du catalyseur. Si la barrière est peu efficace, la croissance des nanotubes/nanofibres sera mal contrôlée.

Les barrières de diffusion utilisées actuellement sont généralement la silice (SiO_2) et le nitrure de titane (TiN). SiO_2 est une

excellente barrière mais c'est un matériau isolant et donc peu adapté dans le cas où il est nécessaire de connecter électriquement les nanotubes. On notera que SiO_2 peut cependant être utilisé en couche très mince (2-4 nm) et que dans ce cas, le passage du courant peut s'effectuer par effet tunnel.

5 SiO_2 se dégrade rapidement lors du passage du courant électrique et il perd alors ses propriétés isolantes. Le TiN est aussi une excellente barrière de diffusion mais uniquement pour des températures de croissance de nanotubes inférieures à 700°C. En effet à partir de 700°C, l'azote constituant le TiN exodiffuse et le matériau perd alors ses propriétés de barrière de

10 diffusion.

Dans ce contexte, l'invention propose d'utiliser des barrières de diffusion originales destinées à la croissance catalytique de nanotubes et nanofibres, et adaptées aux catalyseurs de type nickel, cobalt, fer, platine, yttrium ou de tout autre alliage basé sur l'un au moins de ces composants.

15 Plus précisément, l'invention a pour objet un procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres sur un substrat comportant au moins une couche supérieure en un premier matériau, caractérisé en ce qu'il comprend :

- 20 - la formation à la surface de la couche supérieure, d'une couche barrière constituée d'un alliage du premier matériau et d'un second matériau, ledit alliage étant stable à une première température ;
- la formation de plots de catalyseur constitués du second matériau, à la surface de la couche d'alliage ;
- 25 - la croissance de nanotubes ou nanofibres à une seconde température inférieure à ladite première température.

Selon une variante de l'invention, la formation de la couche barrière comprend le dépôt d'une couche constituée du second matériau, à la surface de la couche supérieure constituée du premier matériau, puis le

30 recuit à ladite première température.

L'invention consiste ainsi à déposer une couche mince de second matériau constitutif du catalyseur, sur la couche supérieure de premier matériau, puis à effectuer un recuit à une température supérieure ou égale à la température de croissance des nanofibres/nanotubes. On forme ainsi un

35 alliage stable à la température de recuit T_r et donc à la température de

croissance T_c des nanotubes/nanofibres (on a $T_c < T_f$). De ce fait, lorsque l'on utilise ultérieurement des plots de catalyseur, ceux-ci ne réagissent pas avec l'alliage formé préalablement et permettent une croissance catalytique de nanotubes/nanofibres, efficace.

5 Selon une variante de l'invention le procédé comprend le dépôt d'une couche de catalyseur constituée du second matériau à la surface de la couche d'alliage puis la gravure locale de ladite couche de catalyseur de manière à définir les plots de catalyseurs.

 Avantageusement on peut avoir préalablement réaliser des plots
10 de résine sur la couche d'alliage.

 Selon une variante de l'invention, le premier matériau et le substrat sont de nature identique.

 Selon une autre variante de l'invention le premier matériau et le substrat sont de nature différente. Dans ce cas, avantageusement si la
15 couche supérieure de premier matériau comporte un premier nombre d'atomes N_M , et la couche de second matériau comporte un second nombre d'atomes N_A , en réglant $N_M/N_A < x/y$ avec x et y fractions molaires de l'alliage M_xA_y , on parvient lors de la formation de l'alliage, avec le second matériau en excès (par rapport à la formation de l'alliage) à former directement des plots
20 de catalyseur dudit second matériau. Dans ce cas on peut s'affranchir du dépôt ultérieur d'une couche de catalyseur pour former des plots de catalyseur en vue de la formation des nanotubes/nanofibres.

 Avantageusement le premier matériau peut-être du silicium ou un métal.

25 Lorsque la couche d'alliage est obtenue après dépôt d'une couche de second matériau sur la couche supérieure à la surface du substrat et recuit de l'ensemble, cette couche d'alliage peut typiquement avoir une épaisseur comprise entre environ une dizaine de nanomètres et une centaine de nanomètres.

30 L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre et grâce aux figures annexées parmi lesquelles :

- les figures 1a-1d illustrent les étapes d'un procédé de croissance catalytique de nanofibres/nanotubes, selon l'art connu,

- les figures 2a-2e illustrent les étapes d'un exemple de procédé de croissance de nanotubes/nanofibres selon l'invention,
- les figures 3a-3c illustrent les étapes d'un second exemple de procédé de croissance de nanotubes/nanofibres selon l'invention.

Selon l'invention le procédé de croissance de nanotubes/nanofibres comprend la réalisation d'une couche barrière vis-à-vis d'une couche de catalyseur, nécessaire à la croissance des nanotubes/nanofibres.

Selon une variante de l'invention, le procédé comprend la réalisation d'une couche de cobalt d'environ une cinquantaine de nanomètres à la surface d'une couche de silicium, pour réaliser l'alliage CoSi_2 .

La Figure 2 illustre un premier exemple de procédé selon l'invention, dans lequel le substrat et le matériau de la couche supérieure sont de nature différente. (Néanmoins selon d'autres variantes de l'invention, le substrat S peut être lui-même en matériau M).

Selon une première étape, la couche barrière est réalisée par le dépôt préalable d'une couche 12 de matériau A à la surface d'une couche 11 supérieure de matériau M elle-même à la surface d'un substrat S (figure 2a).

On procède alors à une opération de recuit à une température T_r qui permet la formation d'une couche 13 d'alliage M_xA_y (Figure 2b).

De manière classique, on dépose alors une couche 14 de résine 2, que l'on grave. Puis on dépose une couche 15 de matériau catalyseur A (Figure 2c). Après retrait de la résine et excédent de matériau catalyseur A (Figure 2d), on définit des plots 16 de catalyseur A. On procède alors à la croissance des nanotubes 18 d'un matériau B à une température T_c inférieure à la température T_r (Figure 2e), le matériau B pouvant être de type C, SiC, BN...

La Figure 3 illustre un second exemple de procédé selon l'invention dans lequel le choix judicieux des quantités de matériau de catalyseur et de premier matériau permettent de former simultanément une couche d'alliage M_xA_y et des plots de catalyseur en matériau A.

A titre d'exemple on peut citer qu'une couche en matériau M en silicium d'épaisseur 185 Å et une couche en matériau A en nickel d'épaisseur 100 Å, forme à 750°C une couche uniforme d'alliage NiSi. Un défaut de silicium ou un excès de nickel permettent à cette même température de

former une couche d'alliage NiSi avec des plots résiduels en surface de Ni qui pourront directement être utilisés pour la croissance de nanotubes.

Ainsi selon la Figure 3a, on dépose comme dans l'exemple illustré en Figure 2a une couche 11 de matériau M à la surface du substrat S, puis
5 une couche 12 de matériau A à la surface de la couche 11. Les matériaux M et le substrat S doivent être de nature différente pour permettre de maintenir le matériau A en excès par rapport au matériau M.

L'opération de recuit permet la formation simultanée d'une couche 13 d'alliage M_xA_y et de plots 17 de catalyseur correspondant à
10 l'excès de matériau A par rapport au matériau M lors de la formation de l'alliage (Figure 3b).

On procède alors de manière classique à la croissance de nanofibres/nanotubes 18 à partir desdits pots de catalyseur (Figure 3c).

15 Exemple de procédé de croissance de nanotubes selon l'invention :

1^{er} exemple :

Matériau M : Silicium

20 Matériau A : Nickel

Dans le cas d'un substrat de silicium ou d'une couche mince de silicium déposé sur un substrat, on dépose une couche mince de nickel sur le silicium. On effectue alors une opération de recuit à 750°C de façon à fournir le composé NiSi.

25 L'ajout de platine permet d'éviter la formation de l'alliage $NiSi_2$ et donc d'obtenir uniquement le composé NiSi (J.F. Liu et al., J. Appl. Phys. Vol. 90 p. 745 (2001)). L'alliage NiSi constitue alors une barrière de diffusion efficace pour le nickel, si la température de croissance de nanotubes est inférieure à 750 °C. Notons que la croissance localisée et orientée de
30 nanotubes de carbone peut être obtenue à 700°C (K.B.K. Teo et al., Appl. Phys. Lett. Vol. 79 p. 1534 (2001)).

On peut aussi effectuer le recuit à 850°C de façon à former $NiSi_2$ qui constitue une barrière de diffusion pour des nanotubes/nanofibres dont la température de croissance est inférieure à 850°C.

Une température de croissance des nanotubes plus élevée (~800°C au lieu de 700°C) permet généralement d'obtenir des nanotubes de meilleure qualité cristalline et donc caractérisés par de meilleures propriétés électriques.

- 5 Après réalisation d'une barrière de diffusion NiSi (formée à 750°C) ou NiSi₂ (formée à 850°C), on peut alors effectuer la croissance localisée et orientée de nanotubes de carbone à une température de 700°C. Afin d'obtenir la croissance d'un seul nanotube par plot de catalyseur, on définit par lithographie des plots de Nickel de diamètre de l'ordre de 100 nm et
10 d'épaisseur 10 nm. La croissance peut alors être effectuée à 700°C dans un réacteur CVD assisté par un plasma DC (continu) avec une tension de l'ordre de 600 Volts. Un mélange gazeux contenant de l'acétylène et de l'ammoniac ($\sim 20\%$ d'acétylène) à une pression d'environ 5 Torr permet alors d'obtenir une croissance orientée et sélective de nanotubes de carbone (K.B.K. Teo et
15 al., Appl. Phys. Lett. Vol. 79 p. 1534 (2001)).

2^{ème} exemple :

Matériau M : Silicium

Matériau A : Cobalt

- 20 Selon ce second exemple, on réalise le dépôt d'une couche de cobalt à la surface d'une couche de silicium. Pour obtenir un alliage homogène de CoSi₂ et donc éviter la formation de la phase CoSi, on peut avantageusement effectuer le recuit à une température supérieure à 600°C.

- 25 Une épaisseur de l'ordre de 30 à 60nm de cobalt permet d'obtenir après recuit à 800°C l'alliage CoSi₂ (Y. J. Yoon, J. Vac. Sci. Technol. B17 p.627 (1999)). Ce composé formé à 800°C devient alors une barrière de diffusion efficace pour le catalyseur en cobalt, si la température de croissance des nanotubes est inférieure à 800°C.

- 30 3^{ème} exemple :

Matériau M : Silicium

Matériau A : Fer

On peut avantageusement former une couche barrière en FeSi₂, à partir du recuit à 700°C d'une couche de fer à la surface de silicium. Cette

couche barrière peut être utilisée pour la croissance de nanotubes/nanofibres à des températures inférieures à 700°C.

REVENDICATIONS

1. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres sur un substrat (S) comportant au moins une couche supérieure (11) en un premier
5 matériau (M), caractérisé en ce qu'il comprend :

- la formation à la surface de la couche supérieure, d'une couche barrière (13) constituée d'un alliage (M_xA_y) du premier matériau (M) et d'un second matériau (A), ledit alliage étant stable à une première température ;
- 10 - la formation de plots de catalyseur (16, 17) constitués du second matériau (A), à la surface de la couche d'alliage ;
- la croissance de nanotubes ou nanofibres (18) à une seconde température inférieure à ladite première température.

15 2. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon la revendication 1, caractérisé en ce que la formation de la couche barrière comprend le dépôt d'une couche (12) constituée du second matériau (A), à la surface de la couche supérieure (11) constituée du premier matériau, puis le recuit à ladite première température.

20 3. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend :

- le dépôt d'une couche de catalyseur (15), constituée du second matériau (A) à la surface de la couche d'alliage (M_xA_y)
- 25 - la gravure locale de ladite couche de catalyseur, de manière à définir des plots de catalyseur (16).

30 4. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le premier matériau et le substrat sont de nature identique.

35 5. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le premier matériau et le substrat sont de nature différente.

6. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon la revendication 5, caractérisé en ce que la couche supérieure (11) de premier matériau comportant un premier nombre d'atomes N_M , la couche (12) de second matériau comportant un second nombre d'atomes N_A , les nombres
5 N_M et N_A sont tel que $N_M/N_A < x/y$ avec x et y fractions molaires de l'alliage M_xA_y .

7. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le premier matériau est du
10 silicium ou un métal.

8. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon la revendication 7, caractérisé en ce que le second matériau est de type nickel, fer ou cobalt.
15

9. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon la revendication 8, caractérisé en ce que le premier matériau est du silicium, le second matériau est du nickel et la formation de l'alliage NiSi est effectuée en présence de platine.
20

10. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la couche de second matériau a une épaisseur comprise entre environ 10 nanomètres et 100 nanomètres.
25

11. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres, selon les revendications 7 et 8, caractérisé en ce qu'il comprend la réalisation d'une couche de cobalt d'environ une cinquantaine de nanomètres à la surface d'une couche de silicium, pour réaliser l'alliage $CoSi_2$.
30

12. Procédé de croissance de nanotubes ou nanofibres, selon les revendications 7 et 8, caractérisé en ce qu'il comprend la réalisation d'un alliage $FeSi_2$.

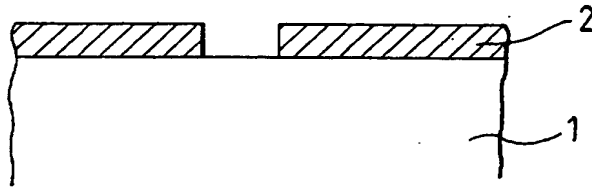


FIG. 1a

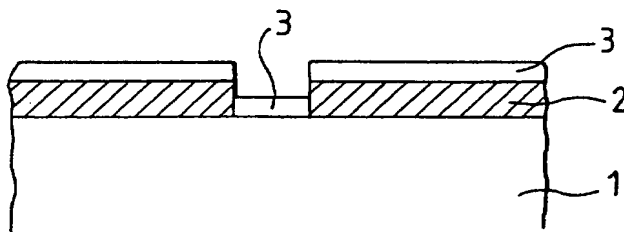


FIG. 1b

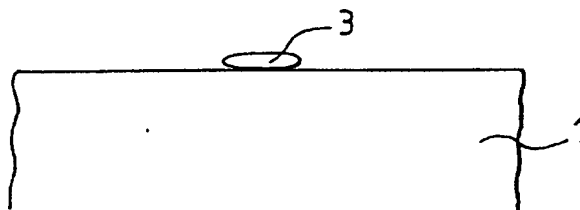


FIG. 1c

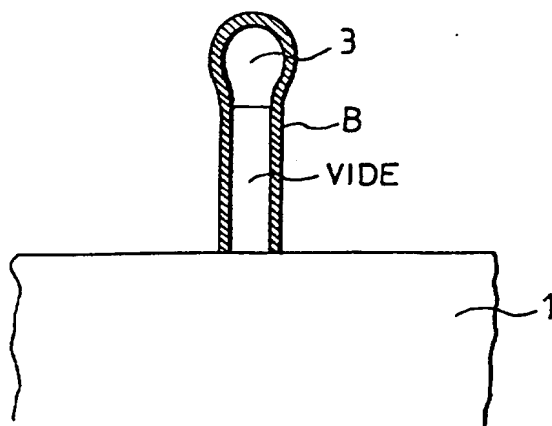


FIG. 1d

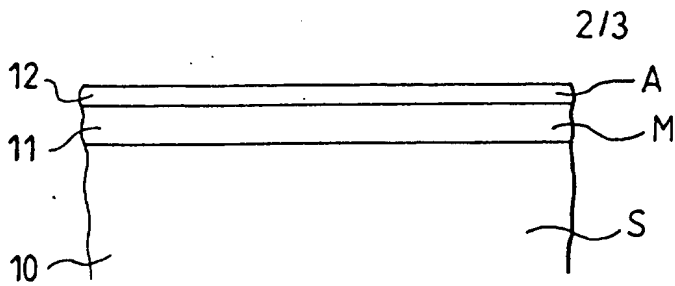


FIG. 2a

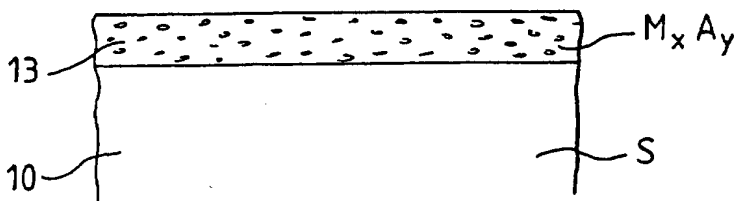


FIG. 2b

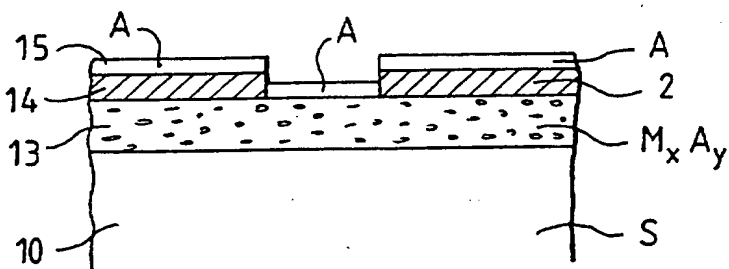


FIG. 2c

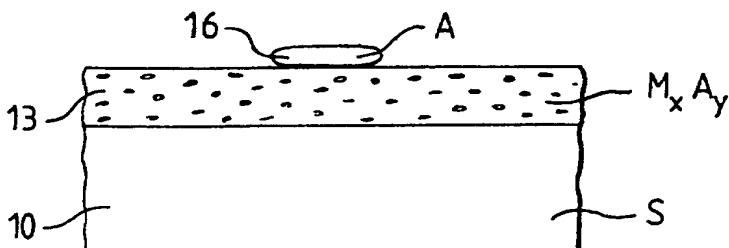


FIG. 2d

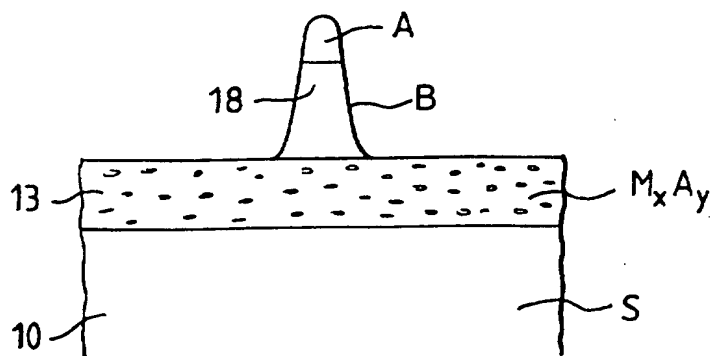


FIG. 2e

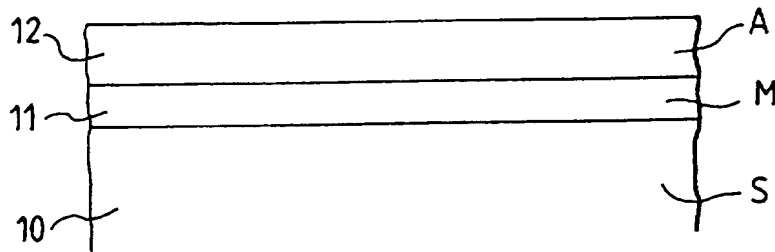


FIG. 3a

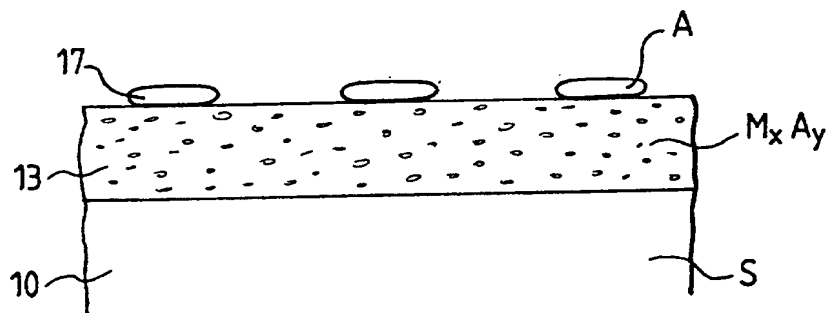


FIG. 3b

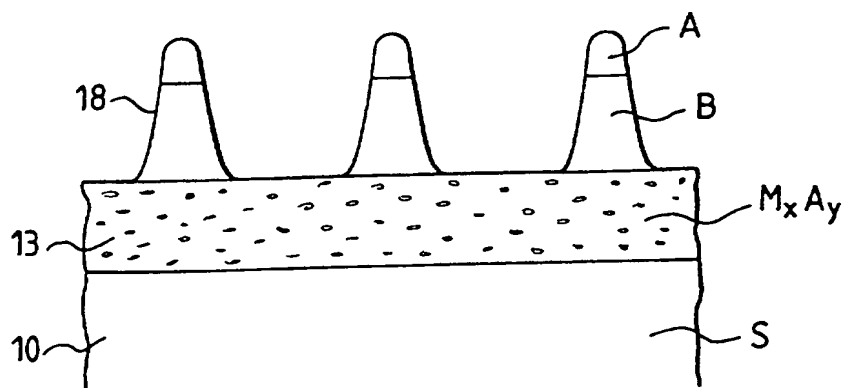


FIG. 3c



2832995

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 612614
FR 0115647

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	EP 1 129 990 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 5 septembre 2001 (2001-09-05) * revendications 1,8-11,15,18 * * page 4, ligne 47 - page 5, ligne 52 * * figures 2A-2E *	1-4,7,8, 10-12	B82B3/00 B32B15/00 C01B31/02 C01B33/06 C01B35/14
A	EP 1 059 266 A (ILJIN NANOTECH CO LTD ; LEE CHEOL JIN (KR)) 13 décembre 2000 (2000-12-13) * colonne 4, ligne 21 - ligne 41 *	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
A	EP 1 046 613 A (ILJIN NANOTECH CO LTD ; JIN JANG (KR)) 25 octobre 2000 (2000-10-25) * revendications 1,3,10 * * colonne 3, ligne 22 - colonne 4, ligne 39 *	1	
A	EP 1 061 043 A (ILJIN NANOTECH CO LTD ; LEE CHEOL JIN (KR)) 20 décembre 2000 (2000-12-20) * revendications 1,2,7,8 * * colonne 4, ligne 12 - ligne 41 *	1	
A	BIRO L P ET AL: "Selective nucleation and growth of carbon nanotubes at the CoSi/sub 2//Si interface" APPLIED PHYSICS LETTERS, 7 FEB. 2000, AIP, USA, vol. 76, no. 6, pages 706-708, XP002214127 ISSN: 0003-6951 * le document en entier *	1	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
19 septembre 2002		Rigondaud, B	
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons</p> <p>& : membre de la même famille, document correspondant</p>			

1

EPO FORM 1503 12.89 (F04C14)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

2832995

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0115647 FA 612614**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 19-09-2002
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1129990	A	05-09-2001	AU	2308501 A	30-08-2001
			EP	1129990 A1	05-09-2001
			JP	2001262343 A	26-09-2001
			US	2002114949 A1	22-08-2002
EP 1059266	A	13-12-2000	CN	1277145 A	20-12-2000
			EP	1059266 A2	13-12-2000
			JP	2001020071 A	23-01-2001
			US	6350488 B1	26-02-2002
EP 1046613	A	25-10-2000	CN	1270920 A	25-10-2000
			EP	1046613 A2	25-10-2000
			JP	2000319783 A	21-11-2000
			US	6331209 B1	18-12-2001
EP 1061043	A	20-12-2000	CN	1277147 A	20-12-2000
			EP	1061043 A1	20-12-2000
			JP	2001020072 A	23-01-2001

EPO FORM P0465

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

THIS PAGE BLANK (Uc